ATM COMMUNICATION NETWORK

Patent Number:

JP9261244

Publication date:

1997-10-03

Inventor(s):

OKI EIJI; YAMANAKA NAOAKI

Applicant(s)::

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP < NTT>

Requested Patent:

☐ JP9261244

Application Number: JP19960072623 19960327

Priority Number(s):

IPC Classification:

H04L12/28; H04Q3/00

EC Classification:

Equivalents:

JP3087949B2

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate invalid cell transfer and to improve s through-put by reporting a congestion state to the ATM switch of a proceding stage when congestion occurs in one of the multistage-connected ATM switches and controlling the abandonment of a cell.

SOLUTION: One vertual channel connection VC#O is formed through the ATM switches 1-3 provided with cell buffer control parats 201 -203 which selectively abandon the cell by the packet level of a host layer in accordance with the congestion state. An EPO state reporting cell generating part 12 which reports the congestion state of one ATM switch 3 to the ATM switches 1 and 2 at the upstream side of VC#O loads information of the congestion stategerenated whernever the cell annulment state in the ATM switch 3 changes in an EPO state rerporting cell which is transmitted to the ATM switches 1 and 2 at the upstream side. The ATM switches 1 and 2 receives the information so as to change the control (cell selecting abandonment) state of the cell based on the received cell.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号 特許第3087949号 (P3087949)

(45) 発行日 平成12年9月18日(2000.9.18)

(24)登録日 平成12年7月14日(2000.7.14)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

H04L 12/28

H04L 11/20

G

請求項の数5(全 11 頁)

(21)出願番号	特顯平8-72623	(73)特許権者	000004226
			日本電信電話株式会社
(22)出顧日	平成8年3月27日(1996.3.27)		東京都千代田区大手町二丁目3番1号
()	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者	大木 英司
		127元列省	八小 天明
(65)公開番号	特開平9-261244		東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日
(43)公開日	平成9年10月3日(1997.10.3)		本電信電話株式会社内
審查請求日	平成11年1月4日(1999,1.4)	(72)発明者	山中 直明
			東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日
			本電信電話株式会社内
		(7 A) (D 700 I	
		(74)代理人	100078237
			弁理士 井出 直孝 (外1名)
		審査官	江嶋 清仁
	•	1)	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ATM通信網

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 輻輳状態にしたがってセルを上位レイヤのパケットレベルで選択的に廃棄する手段を備えたAT Mスイッチの複数個を経由して一つのバーチャルチャネルが形成されるATM通信網において、

一つのATMスイッチの輻輳状態を前記上流側のATM スイッチに宛て送信されるEPD状態通知セル中に前記 輻輳状態の情報を搭載して前記上流側のATMスイッチ に通知する手段を備えたことを特徴とするATM通信 網。

【請求項2】 <u>前記輻輳状態の情報がそのATMスイッ</u> チにおけるセル廃棄状態が変化する毎に生成される請求 項1記載のATM通信網。

【請求項3】 <u>ATMスイッチに、通過するバーチャル</u> チャネルの下流側のATMスイッチから通知される輻輳 2

状態にしたがって、その輻輳状態を通知したATMスイッチを経由するセルの廃棄を制御する手段を備えた請求項1または2記載のATM通信網。

【請求項4】 前記セルの廃棄を制御する手段は、セルの転送を再開する際には前記下流側のATMスイッチから通知される輻輳状態が転送可能な状態になってから時間Tを経過した後に転送を再開する手段を含む請求項3 記載のATM通信網。

【請求項5】 <u>前記時間Tは、そのATMスイッチに設</u> 10 けられたセルバッファのキュー長に応じて適応的に設定 される請求項4記載のATM通信網。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はATM(Asynchronous Transfer Mode:非同期転送モード) 通信に利用する。

本発明はATMスイッチの輻輳状態を回避する技術に関する。

[0002]

【従来の技術】ATM通信網には、データ通信を安価に提供するクラスとして、ベストエフォートクラスが設定されている。ベストエフォートクラスでは、網の使用率を高く利用するため、CBR(Constant Bit Rate) サービスクラスのような帯域の予約なしに運用される。したがって、一般にベストエフォートクラスでは、CBRサービスクラスのような帯域予約型のクラスと比べてセル廃棄率が大きくなる。

【0003】データ通信をベストエフォートクラスで行う場合には、一つのセル廃棄がパケット全体の廃棄と、それに伴う再送をもたらすため、一旦輻輳が起きると網のスループットが著しく低下する恐れがある。この主たる原因は、ATMスイッチのセルバッファにおけるセル廃棄が、複数のパケットに分散してしまうところにある。

【0004】輻輳状態下でATMスイッチのセルバッファでセルが廃棄されたとき、セル損失を包含した不完全 20パケットは、宛先端末まで到達しても、すべて廃棄されてしまう。損失したパケットに対しては、上位レイヤのプロトコルにおいて、エンドツーエンドで再送を行うため、輻輳が生じることになる。

【0005】これを防ぐには、無効なセル廃棄をできるだけ防ぐ選択的なセル廃棄を行う方法がある。特に文献、A. Romanow and S. Floyd, "Dynamics of TCP Traffic overATM Networks", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 13, No. 4, May, 1995, pp. 633-641. に提案されているEPD(Early Packet Disgard)方式がある。

【0006】この従来例を図13を参照して説明する。 図13はEPD方式を説明するための図である。セルバッファ14のバッファ容量に関して閾値を設けておき、 セルバッファ14のキュー長がその閾値を超えたら輻輳 状態と判断して、その時点以降に到着する新しいパケットを構成するすべてのセルを強制廃棄する。

【0007】セルレベルでパケットを識別する方法は、AAL (ATM Adaptation Layer) 5を用いるとき、AAL パケットの終りを示す最終セルを、AUU (ATM User to User) パラメータによって識別することができる。EP D方式では、ベストエフォートクラスのVCI (Virtual Channel Identifier) を記録するテーブルと、EPD方式によって強制廃棄されているかどうかの状態(以下、EPD状態という)を示すテーブルが必要である。前者のテーブルは、コネクションの設定時に作成される。後者のテーブルは、キュー長の状態によって変化する。両者を合わせてここでは、EPD管理テーブルと呼ぶ。

【0008】図14はEPD管理テーブルの例を示す図 である。記号A(アクティブ)は、パケットが転送中で 50 ある状態を示し、記号 I (インアクティブ) はパケット が強制廃棄中である状態を示す。

【0009】図15はEPD方式の動作を示すフローチ ャートである。図16は従来例のセルバッファ制御部の プロック構成図である。図15のフローチャートにした がって、EPD方式のアルゴリズムを説明する。セルが 到着すると (S 6 1) 、当該セルのバーチャルチャネル (以下、VCと記す) コネクションがベストエフォート クラスに属しているか否かをベストエフォートクラス判 定部15がEPD管理テーブル10を参照して判定する (S62)。属していれば当該セルのVCコネクション がアクティブ状態か否かをEPD制御部11がEPD管 理テーブル10を参照して判定する(S63)。また、 ベストエフォートクラスに属していなければ、セルバッ ファ14がフル状態であるか否かを判定し(S70)、 セルバッファ14がフル状態であれば、セル廃棄を行う (S 7 2)。セルバッファがフル状態でなければ、セル 転送を行う(S71)。また、アクティブ状態であり (S63)、セルバッファ14がフル状態であれば(S 64)、当該セルが最終セルか否かを判定し(S6 6) 、最終セルであれば、セル廃棄を行い(S72)、 最終セルでなければインアクティブ状態に変更し(S6 8)、セル廃棄を行う(S72)。アクティブ状態でな く(S63)、当該セルが最終セルならば、アクティブ 状態に変更し(S69)、セル廃棄を行う(S72)。 当該セルが最終セルでなければ、そのままセル廃棄を行 う(S72)。また、アクティブ状態であり(S6 3)、セルバッファ14がフル状態でなければ(S6 4)、当該セルが先頭セルかつ輻輳中であるか否かを判 定する(S65)。当該セルが先頭セルかつ輻輳中であ れば(S65)、インアクティブ状態に変更し(S6 8)、そのセルを廃棄する(S72)。先頭セルかつ輻 輳中でなければ(S65)、セル転送を行う(S7 1)。

【0010】このようにEPD方式では、輻輳中においてセルバッファ溢れによるセル損失が起きる可能性が高いと判断されたパケット全体を、バッファリングしないで強制廃棄しておくことにより、無効なセルの転送または再送を未然に防ぐことができ、輻輳を緩和することができる。

【0011】このようなEPD方式のATMスイッチを 多段に接続した構成例を図17に示す。図18は多段に 接続されたATMスイッチにおけるEPD管理テーブル の状態を示す図である。以降、あるATMスイッチから セル流の下流にあたるATMスイッチをみたとき、この ATMスイッチを後段のATMスイッチと呼ぶ。逆に、 あるATMスイッチからセル流の上流にあたるATMス イッチをみたとき、このATMスイッチを前段のATM スイッチと呼ぶ。すなわち、図17において、ATMス イッチ3からみてATMスイッチ1および2は前段であ 5

る。また、ATMスイッチ1または2からみてATMス イッチ3は後段である。

【0012】また、実際のATMスイッチは双方向に通 信を行っているが、本明細書では説明をわかりやすくす るために、セル流を片方に限定して説明する。

【0013】多段に接続されたATMスイッチ1~3で VCコネクションVC#0に着目する。図18に示すよ うに、EPD状態は、ATMスイッチ1ではアクティ ブ、ATMスイッチ2ではアクティブ、ATMスイッチ 3ではインアクティブとなっている。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】このように、多段に接 続されたATMスイッチでは、それぞれのATMスイッ チ1~3にEPD方式を適用しても、ATMスイッチ3 がインアクティブな状態であると、ATMスイッチ1と ATMスイッチ2がアクティブな状態であったとしても これらのATMスイッチ1、2は無効なセルを転送して いる可能性がある。したがって、多段に接続されたAT Mスイッチでは、後段のATMスイッチ3で輻輳が生じ ると、前段のATMスイッチ1および2で無効なセルの 転送を未然に防ぐことができなくなり、スループットの 向上が期待できなくなる。

【0015】本発明は、このような背景に行われたもの であって、無効なセルの転送をなくすことができるAT M通信網を提供することを目的とする。本発明は、AT Mスイッチスループットを向上させることができるAT M通信網を提供することを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明は、多段に接続さ れたATMスイッチからなるATM通信網であって、い ずれかのATMスイッチで輻輳が生じたとき、その前段 のATMスイッチに輻輳状態を通知し、その情報を受信 したATMスイッチは、セルの制御(セル選択廃棄)状 態を変化させることを最も主要な特徴とする。

【0017】従来技術では、それぞれのATMスイッチ の輻輳状態をATMスイッチ毎に独立に監視し、セルの 制御(セル選択廃棄)もATMスイッチ毎に独立に行っ ていた。本発明は従来技術と比較して、前段のATMス イッチに輻輳状態を通知する手段を備える点、その通知 セルを受信する手段を備える点、および、その受信した セルを基にそのATMスイッチでセルの制御(セル選択 廃棄)状態を変化させる手段を備える点が異なる。

【0018】すなわち、本発明はATM通信網であっ て、輻輳状態にしたがってセルを上位レイヤのパケット レベルで選択的に廃棄する手段を備えたATMスイッチ の複数個を経由して一つのバーチャルチャネルが形成さ れるATM通信網である。本発明の特徴とするところ は、一つのATMスイッチの輻輳状態を前記バーチャル チャネルの上流側のATMスイッチに通知する手段を備 えたところにある。

【0019】前記通知する手段は、前記上流側のATM スイッチに宛て送信されるEPD状態通知セルの中に前 記輻輳状態の情報を搭載する手段を含む構成とすること もできる。

【0020】このとき、前記輻輳状態の情報がそのAT Mスイッチにおけるセル廃棄状態が変化する毎に生成さ れることが望ましい。

【0021】また、前記通知する手段は、前記上流側の ATMスイッチに宛て輻輳状態通知セルを送信する手段 10 を含む構成とすることもできる。

【0022】このとき、そのATMスイッチに設けられ たセルバッファのキュー長に閾値を設定し前記輻輳状態 通知セルに搭載される情報はこの閾値に対するキュー長 の長短情報であることが望ましい。

【0023】ATMスイッチに、通過するバーチャルチ ャネルの下流側のATMスイッチから通知される輻輳状 態にしたがって、その輻輳状態を通知したATMスイッ チを経由するセルの廃棄を制御する手段を備えることが 望ましい。

【0024】これにより、一つのATMスイッチが転送 したセルが後段のATMスイッチによって廃棄されてし まうといった不要なセル転送を回避することができるた め、ATMスイッチのスループットを向上させることが できる。

【0025】また、後段のATMスイッチが未だEPD 制御によるセルの廃棄を実行していなくても、これから 発生するであろう輻輳状況をセルバッファのキュー長か ら予測することにより、実際に後段のATMスイッチで セル廃棄が実行される以前に、その前段のATMスイッ チでセル廃棄を実行し、輻輳状況の回避をきわめて短時 間に行うことができる。

【0026】前記セルの廃棄を制御する手段は、セルの 転送を再開する際には前記下流側のATMスイッチから 通知される輻輳状態が転送可能な状態になってから時間 Tを経過した後に転送を再開する手段を含む構成とする こともできる。

【0027】前記時間Tは、そのATMスイッチに設け られたセルバッファのキュー長に応じて適応的に設定さ れるようにしてもよい。

【0028】これにより、セル転送の再開に際し、後段 のATMスイッチに対し、急激にトラヒック量が増加す ることを緩和することができる。この時間Tは、前記輻 輳状況にしたがって適応的に設定されるようにすること により、輻輳状況の程度に適応した制御を行うことがで きる。

[0029]

【発明の実施の形態】

[0030]

【実施例】

50 (第一実施例) 本発明第一実施例の構成を図1および図 (4)

2を参照して説明する。図1は本発明第一実施例の全体 構成を示す概念図である。図2は本発明第一実施例のセ ルバッファ制御部のブロック構成図である。

【0031】本発明はATM通信網であって、輻輳状態 にしたがってセルを上位レイヤのパケットレベルで選択 的に廃棄する手段としてのセルバッファ制御部201~ 203 を備えたATMスイッチ1~3を経由して一つの VC#0が形成されるATM通信網である。

【0032】ここで、本発明の特徴とするところは、一 つのATMスイッチ3の輻輳状態をVC#0の上流側の ATMスイッチ1および2に通知する手段としてのEP D状態通知セル生成部12を備えたところにある。

【0033】EPD状態通知セル生成部12は、上流側 のATMスイッチ1および2に宛て送信されるEPD状 態通知セルの中に前記輻輳状態の情報を搭載する手段を 含む。また、前記輻輳状態の情報はそのATMスイッチ 3におけるセル廃棄状態が変化する毎に生成される。

【0034】次に、本発明第一実施例の動作を図3ない し図5を参照して説明する。図3は本発明第一実施例の EPD管理テーブルの状況を示す図である。図4は本発 明第一実施例のEPD状態通知セルを前段のATMスイ ッチに通知する動作を示すフローチャートである。図5 は本発明第一実施例のEPD状態通知セルを受信する動 作を示すフローチャートである。図2は、図4の動作と 図5の動作の双方の動作を行うことができる例を示して あるが、どちらか一方の動作を行える構成とすることも できる。

【0035】本発明第一実施例のセルバッファ制御部2 0の動作の特徴は、従来例で説明した動作に加えて以下 のような動作を特徴とする。図3に示すように、VCコ ネクションのVC#0に着目する。従来例で示した図1 8では、ATMスイッチ3のEPD管理テーブル103 では、VC#Oはインアクティブ状態であるが、ATM スイッチ1のEPD管理テーブル101 とATMスイッ チ2のEPD管理テーブル102では、VC#0はアク ティブ状態となっている。本発明第一実施例は、図3の ように、ATMスイッチ3のEPD管理テーブル103 においてVC#0に対応するVCI=25のEPD状態 がインアクティブ状態に移行したとき、EPD状態通知 セルを前段のATMスイッチ1および2に送出する。前 段のATMスイッチ1および2において、例えばATM スイッチ2では、VC#0に対応するVCI=72のE PD状態をインアクティブ状態に変更する。また、AT Mスイッチ1では、VC#0に対するVCI=3のEP D状態をインアクティブ状態に変更する。

【0036】本発明第一実施例のEPD状態通知セルを 前段スイッチに通知する動作を図4のフローチャートを 用いて説明する。あるVCコネクションのEPD状態が 変更したとする(S1)。この状態変更は、インアクテ ィブ状態からアクティブ状態に変更になる場合と、アク

ティブ状態からインアクティブ状態に変更になる場合が ある (S2)。インアグティブ状態からアクティブ状態 に変更になるとき、アクティブ状態を通知するEPD状 態通知セルをEPD状態通知セル生成部12で生成する (S3)。EPD状態通知セルは、例えば、セルヘッダ の数ピットを用いて識別できるようにする。EPD状態 通知セルがアクティブ状態を通知するという情報は、セ ルヘッダまたはペイロードに書込まれる。図2におい て、EPD制御部11によってEPD状態が変更した信 号がEPD状態通知セル生成部12に送出され、EPD 状態通知セル生成部12においてアクティブ状態を通知 するEPD状態通知セルが生成される。また、アクティ ブ状態からインアクティブ状態に変更になるとき(S 2) 、インアクティブ状態を通知するEPD状態通知セ ルを生成する(S4)。このインアクティブ状態を通知

するEPD状態通知セルもEPD状態通知セル生成部1

2において生成される。EPD状態通知セルは、前段の

ATMスイッチ1および2に送出される(S5)。

【0037】EPD状態通知セルを前段のATMスイッ チ1および2で受信する動作を図5を用いて説明する。 EPD状態通知セルを受信したATMスイッチ1および 2は(S11)、該当するVCコネクションに対してア クティブ通知かインアクティブ通知かを識別する(S1 2)。この識別は、図2のEPD状態通知セル受信部1 3で行う。もし、アクティブ通知であれば、当該VCコ ネクションがアクティブ状態であるかインアクティブ状 態であるかをEPD管理テーブル10を参照して判定す る(S13)。アクティブ状態であれば、EPD状態は 変更しない。アクティブ状態でなければ(インアクティ ブ状態であれば)、パケットの最終セルを受信し(S1 4)、輻輳中でなければ(キュー長が閾値を超えていな ければ) (S15)、アクティブ状態に変更する(S1 また、インアクティブ通知であれば(S12)、 当該VCコネクションがアクティブ状態であるかインア クティブ状態であるかをEPD管理テーブル10を参照 して判定する(S18)。インアクティブ状態であれ ば、EPD状態は変更しない。インアクティブ状態でな ければ(アクティブ状態であれば)、インアクティブ状 態に変更する(S19)。図3にもあるように、EPD 状態通知セルは、当該スイッチ動作とともに、さらに前 段のATMスイッチに送出される。

【0038】このように、EPD状態通知セルを用いる ことにより、後段のATMスイッチ3のEPD状態の変 化を通知し、前段のATMスイッチ1および2でEPD 状態を変化させることができる。したがって、前段のA TMスイッチ1および2で無効なセルの転送を未然に防 ぐことができ、スループットを向上することができる。 【0039】 (第二実施例) 本発明第一実施例では、各

VCコネクションの後段のATMスイッチ3のEPD状 態変化をEPD状態通知セルによって、前段のATMス イッチ1および2に通知していた。本発明第二実施例では、各VCコネクションの後段のATMスイッチ3のEPD状態の変化を通知するのではなく、セルバッファ14の閾値によって後段のATMスイッチ3の輻輳状態を判定し、後段のATMスイッチ3の輻輳状態の変化を輻輳状態通知セルによって、前段のATMスイッチ1および2に通知する。キュー長が閾値を超えるとき、輻輳状態に変化することになる。また、キュー長が閾値より小さくなるとき、輻輳状態が解除されたことになる。

【0040】輻輳状態通知セルは、本発明第一実施例と同様にVCコネクション毎に生成する。また、VCコネクションが同一の経路(同一のスイッチを経由している)に属しているとき、同一の経路毎に輻輳状態通知セルを生成することもできる。以下では、本発明第一実施例と同様にVCコネクション毎に生成する場合について説明する。

【0041】図6は本発明第二実施例の全体構成を示す 概念図である。図7は本発明第二実施例のEPD管理テ ーブルの状況を示す図である。図8は本発明第二実施例 の輻輳状態通知セルを前段のATMスイッチに通知する 動作を示すフローチャートである。図9は本発明第二実 施例の輻輳状態通知セルを受信する動作を示すフローチ ャートである。図10は本発明第二実施例のセルバッフ ア制御部のブロック構成図である。本発明第二実施例の 輻輳状態通知セルをATMスイッチ3が前段のATMス イッチ1および2に通知する動作を図8のフローチャー トを用いて説明する。キュー長の変化により輻輳状態が 変更したとする (S20)。図6にあるように、キュー 長が閾値を超えたとき、ATMスイッチ3でVCコネク ションのVC#0 (VCI=25) のEPD状態がアク ティブ状態であっても、この状態変更は、輻輳状態に変 更になる場合と、輻輳解除状態に変更になる場合がある (S21)。輻輳状態に変更になるとき、輻輳状態を通 知する輻輳状態通知セルを生成する(S22)。輻輳状 態通知セルは、例えば、セルヘッダの数ビットを用いて 識別できるようにする。輻輳状態通知セルが輻輳状態を 通知するという情報は、セルヘッダまたはペイロードに 魯込まれる。図10において、セルバッファ14によっ て輻輳状態が変更した信号が輻輳状態通知セル生成部1 6に送出され、輻輳状態通知セル生成部16において輻 輳状態を通知する輻輳状態通知セルが生成される。ま た、輻輳解除状態に変更になるとき、輻輳解除状態を通 知する輻輳状態通知セルを生成する(S23)。この輻 輳解除状態を通知する輻輳状態通知セルも輻輳状態通知 セル生成部16において生成される。図7にあるよう に、キュー長が閾値を超えたとき、ATMスイッチ3で $VC = \lambda / 2$ 状態がアクティブ状態であっても、輻輳状態通知セルを 送出することが本発明第一実施例と異なる。輻輳状態通 知セルは、前段のATMスイッチ1および2に送出され 50

る(S24)。

(5)

【0042】輻輳状態通知セルを前段のATMスイッチ 1および2で受信する動作を図9を用いて説明する。輻 輳状態通知セルを受信したATMスイッチ1および2は (S31)、該当するVCコネクションに対して輻輳通 知か輻輳解除通知かを識別する (S32)。この識別 は、図10の輻輳状態通知セル受信部17で行う。も し、輻輳通知であれば、当該VCコネクションがアクテ ィブ状態であるかインアクティブ状態であるかをEPD 10 管理テーブル10を参照して判定する(S33)。アク ティブ状態であれば、EPD状態は変更しない。アクテ ィブ状態でなければ(インアクティブ状態であれば) (S33)、パケットの最終セルを受信し(S34)、 輻輳中でなければ(キュー長が閾値を超えていなけれ ば) (S35)、アクティブ状態に変更する(S3 7)。また、輻輳解除通知であれば(S32)、当該V Cコネクションがアクティブ状態であるかインアクティ ブ状態であるかをEPD管理テーブル10を参照して判 定する(S38)。インアクティブ状態であれば、EP D状態は変更しない。インアクティブ状態でなければ (アクティブ状態であれば)、インアクティブ状態に変 更する(S39)。輻輳状態通知セルは、当該ATMス イッチ1および2の動作とともに、さらに前段のATM スイッチに送出される。

【0043】このように、輻輳状態通知セルを用いることにより、後段のATMスイッチ3の輻輳状態の変化を通知し、前段のATMスイッチ1および2でEPD状態を変化させることができる。したがって、前段のATMスイッチ1および2で無効なセルの転送を未然に防ぐことができ、スループットを向上することができる。

【0044】 (第三実施例) 本発明第三実施例を図11 および図12を参照して説明する。図11は本発明第三 実施例のEPD状態通知セルを受信する動作を示すフロ ーチャートである。図12は本発明第三実施例のセルバ ッファ制御部のブロック構成図である。本発明第一実施 例では、アクティブ状態に変更になった情報をもつEP D状態通知セルを受信したとき、図5のフローチャート にあるように、最終セルを受信し(S14)、輻輳中 (閾値を超えている)でなければ(S15)、アクティ ブ状態に変更していた (S17)。本発明第三実施例で は、タイマ18により、アクティブ状態に変更になった 情報をもつEPD状態通知セルを受信したとき、タイマ 18によりT(一定)時間経過後(S44)、最終セル を受信し(S45)、輻輳中(閾値を超えている)でな ければ(S46)、アクティブ状態に変更する(S4 8)。他の動作は本発明第一実施例と同様なので説明は 省略する。

【0045】タイマ18により、EPD状態を変化させる時間が制御されるが(S44)、さらに前段のATMスイッチにEPD状態通知セルを送出するタイミング

は、例えば、本発明第一実施例と同様にタイマ18とは 関係ない。

【0046】本発明第三実施例では、EPD状態通知セ ルを利用した本発明第一実施例に対応しているが、輻輳 状態通知セルを利用した本発明第二実施例に対応してタ イマ18を備えても同様の動作が可能である。

【0047】このように、タイマ18を利用することに より、前段のATMスイッチ1および2がEPD状態通 知セルのアクティブ状態を受信しても、すぐにアクティ ブ状態にならない。したがって、後段のATMスイッチ 10 3に対して、急激にトラヒック量が増加するのを防ぐこ とができる。

【0048】 (第四実施例) 本発明第三実施例では、タ イマ時間をT時間と一定にしている。本発明第四実施例 では、後段のATMスイッチ3のセルバッファ14のキ ュー長の情報をEPD状態通知セル(本発明第一実施例 に対応) または輻輳状態通知セル (本発明第二実施例に 対応) に乗せ、前段のATMスイッチ1および2ではA TMスイッチ3のキュー長に応じてタイマ時間を適応的 に設定することが特徴である。例えば、キュー長が長い 20 ときは、タイマ時間を長くし、キュー長が短いときは、 タイマ時間を短くする。

【0049】このように、前段のATMスイッチ1およ び2では後段のATMスイッチ3のキュー長に応じてタ イマ時間を設定することにより、後段のATMスイッチ 3に対して、急激にトラヒック量が増加するのを防ぐこ とができる。さらに、本発明第四実施例では、タイマ時 間をキュー長にしたがって適応的に変化させているの で、本発明第三実施例に比較してより実際の輻輳状況の 現状に則した制御を行うことができる。

[0050]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 無効なセルの転送をなくすことができる。したがって、 ATMスイッチスループットを向上させることができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明第一実施例の全体構成を示す概念図。

【図2】本発明第一実施例のセルバッファ制御部のブロ ック構成図。

【図3】本発明第一実施例のEPD管理テーブルの状況 40 18 タイマ

を示す図。

【図4】本発明第一実施例のEPD状態通知セルを前段 のATMスイッチに通知する動作を示すフローチャー ト。

【図5】本発明第一実施例のEPD状態通知セルを受信 する動作を示すフローチャート。

【図6】本発明第二実施例の全体構成を示す概念図。

【図7】本発明第二実施例のEPD管理テーブルの状況 を示す図。

【図8】本発明第二実施例の輻輳状態通知セルを前段の ATMスイッチに通知する動作を示すフローチャート。

【図9】本発明第二実施例の輻輳状態通知セルを受信す る動作を示すフローチャート。

【図10】本発明第二実施例のセルバッファ制御部のブ ロック構成図。

【図11】本発明第三実施例のEPD状態通知セルを受 信する動作を示すフローチャート。

【図12】本発明第三実施例のセルバッファ制御部のブ ロック構成図。

【図13】EPD方式を説明するための図。

【図14】EPD管理テーブルの例を示す図。

【図15】EPD方式の動作を示すフローチャート。

【図16】従来例のATMセルバッファ制御部のブロッ ク構成図。

【図17】EPD方式のATMスイッチを多段に接続し た構成例を示す図。

【図18】多段に接続されたATMスイッチにおけるE PD管理テーブルの状態を示す図。

【符号の説明】

30 1~3 ATMスイッチ

10、10₁~10₃ EPD管理テーブル

20、201~203 セルバッファ制御部

11 EPD制御部

12 EPD状態通知セル生成部

13 EPD状態通知セル受信部

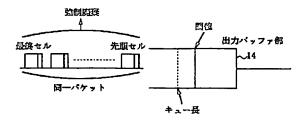
14 セルバッファ

15 ベストエフォートクラス判定部

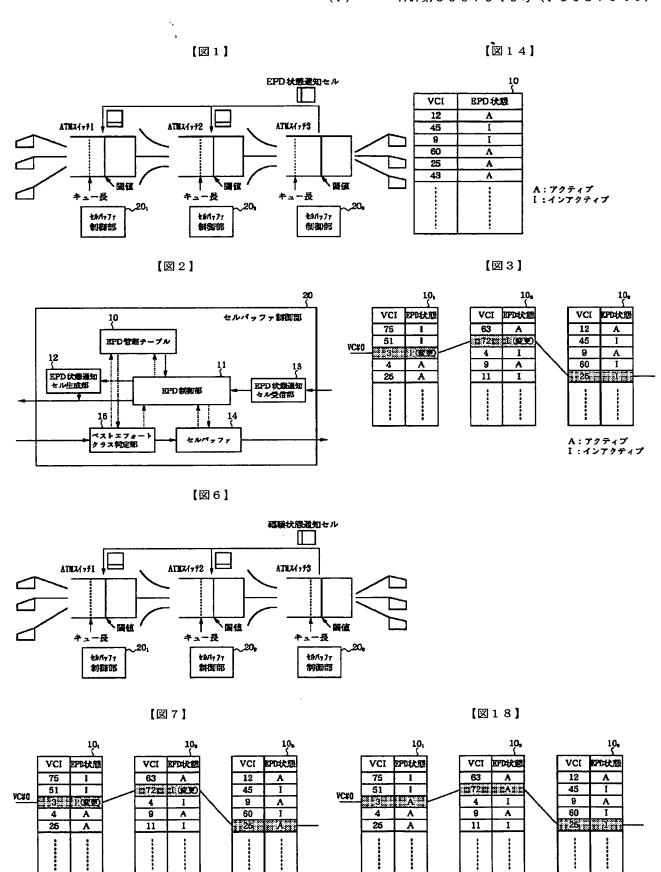
16 輻輳状態通知セル生成部

輻輳状態通知セル受信部 17

【図13】

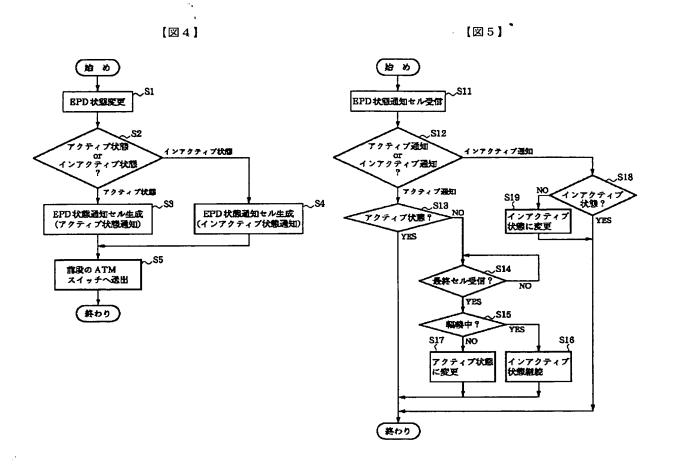


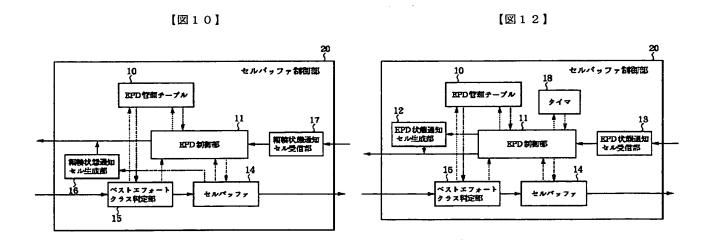
A:アクティブ I:インアクティブ



A: アクティブ I:インアクティブ

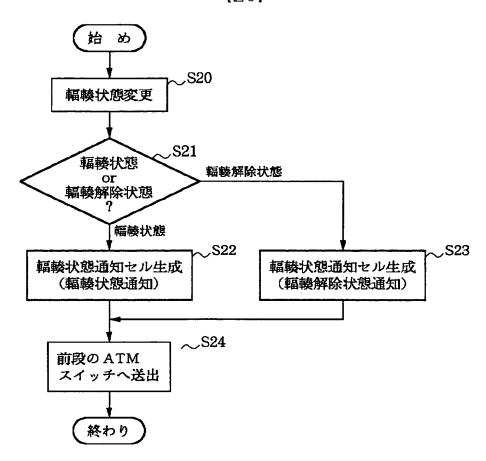




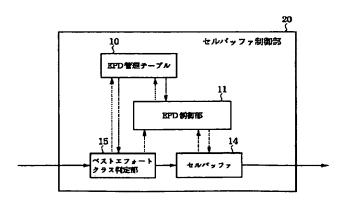


【図17】 ATMA(+f3 ATMX{+f1 ATMX1+f2

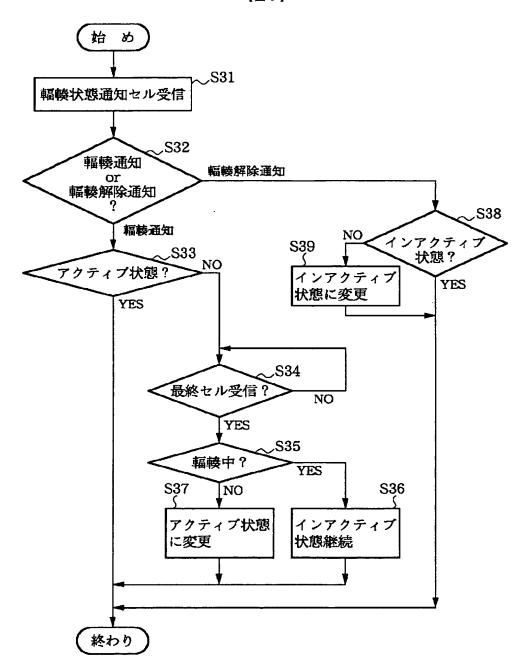
【図8】



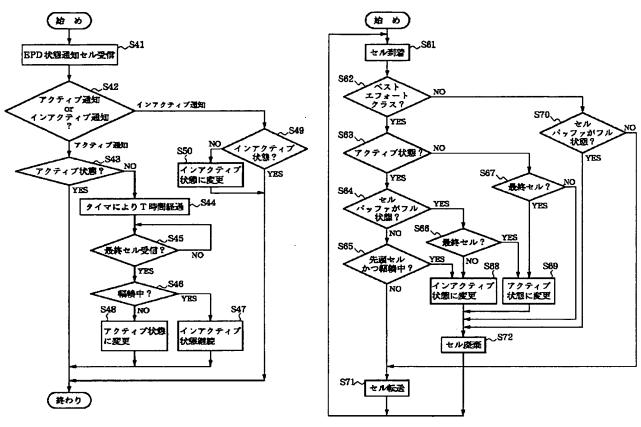
【図16】



【図9】



【図15】 【図11】



フロントページの続き

電子情報通信学会技術研究報告 SS (58)調査した分野(Int.Cl.⁷, DB名) (56)参考文献 E94-94 (1994年9月1日)

電子情報通信学会技術研究報告 IN

94-41 (1994年5月13日)

H04L 12/28

H04L 12/56